

تأثیر نانوذرات پلاسمونیک بر کارایی سلول های فوتوولتاییک پلیمری

سیده محبوبه موسوی فر^۱، محسن قاسمی^{۱,۲*}، غلامحسین حیدری^۳

^۱گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد

^۲مرکز پژوهشی نانو فناوری، دانشگاه شهرکرد

^۳گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر

Email: ghasemi.mohsen@sci.sku.ac.ir

m.mosavifar642@gmail.com

چکیده- در این مقاله، اثر نانوذرات پلاسمونیک بر کارایی سلول های فوتوولتاییک آلی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سلول های فوتوولتاییک پلیمری در حالت متعارف و در حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره با ساختارهای $ITO/PEDOT:PSS/Ag/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al$ و $ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al$ ساخته شدند. برای بهبود خواص پلاسمونیک نقره پس از لایه نشانی، عملیات حرارت دهی در دو دمای متفاوت ۱۸۰ و ۱۲۰ درجه سلسیوس انجام گردید. پارامترهای فوتوولتاییک سلول ها تعیین و نقش نانو ذرات پلاسمونیک نقره بر عملکرد سلول تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره باعث افزایش جذب لایه فعال سلول شده و در نتیجه بازده سلول های فوتوولتاییک پلیمری را بهبود می بخشد. کلید واژه- بازده جذب، پلاسمونیک، سلول فوتوولتاییک پلیمری، نانو ذرات نقره

The effect of plasmonic nanoparticles on the performance of polymeric photovoltaic cells

Sayyideh Mahboubeh Mousavifar¹, Mohsen Ghasemi^{1,2*}, Gholamhosain Haidari³

¹Department of Physics, Faculty of Sciences, Shahrood University

²Nanotechnology Research Center, Shahrood University

³Department of Physics, Faculty of Sciences, Malayer University

Abstract- In this paper, the effect of plasmonic nanoparticles on performance of organic photovoltaic cells has been investigated. For this purpose, polymer photovoltaic cells were fabricated in the conventional structure as well as the presence of silver plasmonic nanoparticles, with the structures $ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al$ and $ITO/PEDOT:PSS/Ag/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al$, respectively. In order to enhance the plasmonic properties of the Ag, after deposition, heat treatment was performed at two different temperatures of 180 °C and 120 °C. The photovoltaic parameters of the cells were determined and the role of silver plasmonic nanoparticles on the performance of the cell was analyzed. The results show that the presence of silver plasmonic nanoparticles increases the absorption of active layer and, consequently, improves the efficiency of the polymer photovoltaic cells.

Keywords: Absorption efficiency, Plasmonic, polymer photovoltaic cell, Silver Nanoparticle

۱- مقدمه

شکل ۱: ساختار نوعی سلول خورشیدی با نانوذرات پلاسمونیک نقره.

شکل ۱ طرح نمادین از ساختار سلول فوتوولتاییک تحت مطالعه در حضور نانوذرات نقره را نشان می‌دهد. در ساخت سلول فوتوولتاییک پلیمری بدون حضور نانوذرات با ساختار (۱) ابتدا لایه‌های تجاری در دسترس ITO را به‌عنوان آند با مقاومت سطحی $15 \Omega/\text{sq}$ با استفاده از اسید کلریدریک سونش دادیم. سپس فرآیند شست و شو با استفاده از استون، ایزو-پروپانول، اتانول و آب دیونیزه، برای هر کدام به مدت ۵ دقیقه درون دستگاه آلتراسونیک انجام شد. در ادامه لایه انتقال دهنده حفره PEDOT:PSS با روش لایه‌نشانی چرخشی با سرعت چرخشی ۳۲۰۰ دور بر دقیقه و زمان چرخش ۴۰ ثانیه لایه‌نشانی گردید. پس از لایه‌نشانی به مدت ۱۵ دقیقه در دمای 120°C عملیات بازپخت انجام شد. برای تهیه نسبت ۱:۱ از P3HT:PCBM، 0.17 g از P3HT در 1 mL دی کلروبنزن و همچنین 0.17 g از PCBM در 1 mL دی کلروبنزن مجزا از هم، به مدت ۶۰ دقیقه در دمای 45°C حل شد. پس از این مرحله، دو محلول به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط مخلوط شدند. پس از مراحل آماده سازی، P3HT:PCBM با روش لایه‌نشانی چرخشی با سرعت چرخشی ۱۲۰۰ دور بر دقیقه و زمان چرخشی ۶۰ ثانیه لایه‌نشانی شد. جهت افزایش ضخامت لایه جاذب P3HT:PCBM لایه‌نشانی در دو مرحله پشت سرهم دو مرتبه تکرار گردید. سپس به مدت ۲۰ دقیقه در دمای 150°C نمونه مورد بازپخت قرار گرفت. لایه BCP به عنوان سد کننده اکسیتونی با ضخامت 11 nm و سپس LiF با ضخامت $1/2 \text{ nm}$ و در نهایت کاتد Al با ضخامت 100 nm به روش تبخیر حرارتی لایه‌نشانی گردیدند. به منظور بررسی اثر نانوذرات پلاسمونیک بر عملکرد سلول خورشیدی مورد نظر در ساختار (۲)، با استفاده از دستگاه تبخیر حرارتی نقره در فشار نهایی $5 \times 10^{-5} \text{ mbar}$ با آهنگ انباشت 0.05 nm/s به ضخامت اسمی 4 nm بر روی لایه ITO/PEDOT:PSS لایه‌نشانی شد. جهت بهره‌وری از خاصیت پلاسمونیک نقره پس از لایه‌نشانی ملزم به حرارت‌دهی هستیم. این فرآیند در دو دمای مختلف بالا و پایین انجام می‌شود تا نقره تحت تأثیر خاصیت تجمع پذیری، از حالت نزدیک به لایه‌ای یکنواخت خارج شود و

در دهه‌های اخیر با بروز بحران‌های زیست محیطی و همچنین کاهش منابع انرژی تجدیدناپذیر، توسعه فناوری سلول‌های فتوولتاییک به عنوان منابع جدید تولید جریان الکتریکی از نور مورد توجه قرار گرفته است. سلول‌های فتوولتاییک آلی بدلیل سهولت ساخت، روش‌های متنوع ساخت، هزینه ی کم ساخت و امکان تولید بر روی بستره‌های انعطاف پذیر و در مساحت‌های بزرگ توجه محققان و صنایع زیادی را به خود جلب کرده است. سلول فتوولتاییک ارتقاء یافته با نانو ذرات پلاسمونیک، نسل جدید سلول‌های فتوولتاییک است که با افزوده شدن نانوذرات فلزی با استفاده از فرآیندهای متنوع باعث گیراندازی نور در سلول، افزایش جذب نور فرودی و در نتیجه افزایش تولید الکتریسیته توسط سلول فتوولتاییک می‌شود. در سلول‌های فتوولتاییک فرایند تبدیل نور به جریان الکتریکی شامل جذب فوتون، تولید اکسایتون، جدایش اکسایتون و ترابرد بار به سمت الکترودها در لایه فعال سلول رخ می‌دهد [۱]. در این پژوهش ابتدا سلول فوتوولتاییک پلیمری متعارف، با پیوند ناهمگون حجمی با لایه فعال P3HT:PCBM در حضور لایه‌های میانگیر انتقال دهنده حفره و سد کننده اکسایتونی تهیه و سپس سلول ارتقاء یافته با حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره ساخته گردید. در ادامه به بررسی و تجزیه تحلیل نقش پلاسمونیک نانوذرات نقره بر عملکرد سلول فوتوولتاییک پلیمری پرداخته شد.

۲- مواد و روش

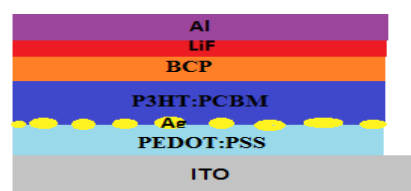
به منظور بررسی اثر نانوذرات پلاسمونیک نقره در سلول فتوولتاییک آلی پلیمری، دو ساختار زیر را در نظر گرفتیم:

ساختار (۱):

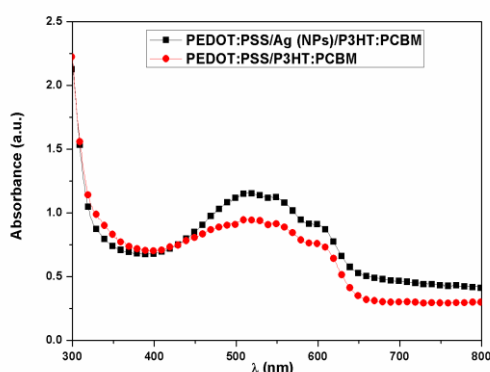
ITO/ PEDOT:PSS /P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al

ساختار (۲):

ITO/PEDOT:PSS/Ag/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al

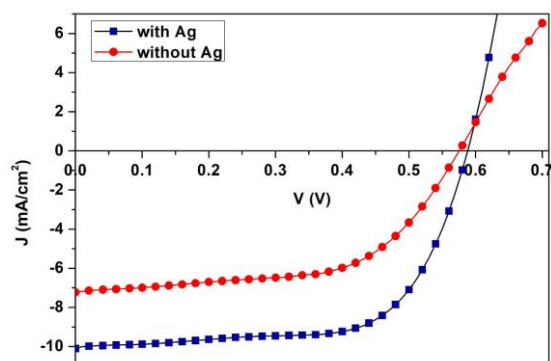


در لایه فعال پلیمر: فولرین کمتر از الکترون‌هاست. این بدین معناست که حفره‌ها آهسته‌تر از الکترون‌ها به فصل مشترک‌ها می‌رسند. از سوی دیگر، میدان الکتریکی موضعی در مجاورت نانوذرات نقره که با تشدید پلاسمون-های سطحی موضعی نانوذرات ایجاد می‌شود، با افزایش فاصله از ذره، کاهش می‌یابد. بنابراین، حفره‌های نزدیک به فصل مشترک بین لایه‌های میانگیر و فعال می‌توانند از میدان الکتریکی قوی‌تری بهره‌مند شوند و باعث تسریع در انتقال حفره‌ها به آند می‌شود.



شکل ۳: طیف جذب لایه‌های میانگیر و فعال با حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره و بدون حضور آن‌ها

اثرات ناشی از حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره و عدم حضور آن‌ها در منحنی مشخصه J-V در حالت روشنایی، تحت تابش با شدت 100 mW/cm^2 در استاندارد AM 1.5، در شکل ۴ نشان داده شده است.

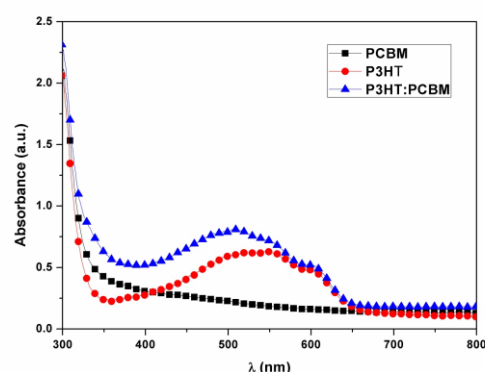


شکل ۴: منحنی مشخصه چگالی جریان-ولتاژ، با حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره و بدون حضور آن‌ها تحت روشنایی

به حالت نزدیک به نانوذرات مجزا بیشتر تبدیل گردد. بنابراین در کوره در شرایط خلأ ابتدا به مدت ۱۵۰ دقیقه در دمای بالای 180°C و سپس به مدت ۱۸۰ دقیقه در دمای پایین 120°C مورد بازپخت قرار گرفت. پس از این مراحل لایه سدکننده اکسیتونی BCP و کاتد LiF/Al انباشت گردیدند. همه شرایط آزمایش برای دو ساختار یکسان در نظر گرفته شد.

۳- بحث و نتایج

طیف جذب P3HT:PCBM و P3HT:PCBM در شکل ۲ نشان داده شده است. P3HT دارای باند جذب گسترده و قوی در طول موج ۴۰۰ تا 650 nm است و PCBM دارای جذب قوی در محدوده فرابنفش با طول موج ۳۰۰ تا 350 nm است. همان‌گونه که در شکل ۲ دیده می‌شود پس از مخلوط کردن P3HT و PCBM، مقدار جذب در ناحیه جذبی P3HT و در ناحیه جذب اشعه ماوراء بنفش PCBM تقویت می‌شود، که به علت برهم‌نهی جذب و اثر ناهمگونی P3HT و PCBM است [۲].



شکل ۲: طیف جذب P3HT، PCBM و P3HT:PCBM برحسب طول موج

به منظور نشان دادن بهبود کارایی سلول فوتوولتاییک دارای نانوذرات پلاسمونیک، طیف جذب با حضور نانوذرات نقره و بدون حضور آن‌ها مطالعه شد. شکل ۳ مقایسه طیف جذب دو ساختار زیر را نشان می‌دهد:

ITO/PEDOT:PSS/Ag/P3HT:PCBM
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM

با مقایسه دو منحنی، شدت جذب در حضور نانوذرات پلاسمونیک نقره به طور واضح افزایش یافته است. همچنین در ساختار لایه پلیمری، تحرک‌پذیری حفره‌ها

کند و در نتیجه منجر به کارایی بهتر سلول‌های فوتوولتاییک آلی پلیمری می‌شود [۲ و ۳].

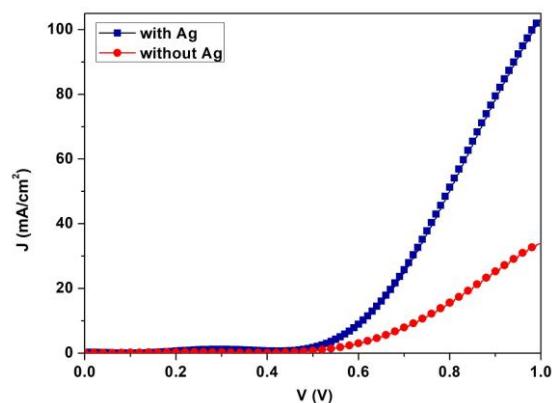
منحنی مشخصه چگالی جریان- ولتاژ سلول‌ها در وضعیت تاریکی نیز در شکل ۵ نشان داده شده است. چنانچه از شکل پیداست تزریق حامل بار درون سلولی که دارای نانوذرات نقره است به شکل مؤثرتری انجام می‌شود به طوری که در ولتاژ اعمالی ۱ ولت، جریان سلول در حدود ۵ برابر سلول بدون نانوذرات نقره است که اهمیت بررسی اثرهای الکترونیکی منتج از نانوذرات نقره در کنار اثرات اپتیکی و اهمیت آنها را نشان می‌دهد [۴].

۴- نتیجه‌گیری

عملکرد سلول فوتوولتاییک آلی پلیمری در حضور نانوذرات پلاسmoniکی نقره و بدون حضور نانوذرات بررسی شد. از آنجایی که میدان الکتریکی ایجاد شده در حضور نانوذرات پلاسمون‌های سطحی موضعی با فاصله از فصل مشترک کاهش می‌یابد، مناسب‌ترین مکان برای لایه‌نشانی نانوذرات نقره و بهره‌مندی از خواص آن در حد فاصل بین لایه میانگیر PEDOT:PSS و لایه فعال P3HT:PCBM می‌باشد. پس از مشخصه‌یابی و بررسی پارامترهای سلول فوتوولتاییک پلیمری، نتایج نشان می‌دهد حضور نانوذرات نقره به دلیل تشدید پلاسمون‌های سطحی موضعی باعث افزایش جذب نور در مقایسه با سلول بدون حضور نانوذرات نقره می‌شود که در نتیجه آن تولید اکسیتون بیشتر و افزایش جریان مدار کوتاه و به طور کلی افزایش کارایی سلول را به همراه دارد.

مراجع

- [1] S. Gunes, H. Neugebauer, N.S. Sariciftci, Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention, *Chem. Rev.*, Vol. 107, No. 4, pp. 1324-1338, 2007.
- [2] J. Mulleroa, M. Kaiser, V. Nadazdy, P. Siffalovic, E. Majkova, Optical absorption study of P3HT:PCBM blend photo-oxidation for bulk heterojunction solar cells, *Solar Energy*, vol.134, No.4, p. 314, 2016.
- [3] D. Qu, F. Liu, Y. Huang, W. Xie, Q. Xu, Mechanism of optical absorption enhancement in thin film organic solar cells with plasmonic metal nanoparticles, *Optical Society of America*, Vol. 19, No.24, pp. 24795-24803, 2011.
- [4] J. Blakesley, D. Neher, Relationship between energetic disorder and open-circuit voltage in bulk heterojunction organic solar cells, *Phys. Rev. B*, vol.84, No. 7, p. 210, 2011.



شکل ۵: منحنی مشخصه چگالی جریان- ولتاژ، با حضور نانوذرات پلاسmoniکی نقره و بدون حضور آن در تاریکی.

پارامترهای فوتوولتاییک این دو سلول در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: مشخصات سلول‌های فوتوولتاییک

شماره سلول	مشخصه ی سلول	J_{sc} (mA/cm ²)	V_{oc} (V)	η_p (%)	FF (%)
۱	سلول متعارف	۷/۲۲	۰/۵۷	۲/۴۰	۵۸/۳
۲	سلول دارای نانوذرات پلاسmoniکی	۱۰/۱۰	۰/۵۸	۳/۸۸	۶۶/۲

از مقایسه پارامترهای فوتوولتاییک مربوط به این دو ساختار در می‌یابیم که با اضافه کردن نانو ذرات نقره در سلول‌های فوتوولتاییک پلیمری P3HT:PCBM، مقدار جریان مدار کوتاه (J_{sc}) از مقدار ۷/۲۲ به ۱۰/۱ (mA/cm²) و ضریب پرشدگی (FF) از مقدار ۵۸/۳ به ۶۶/۲٪ افزایش می‌یابد. همان‌گونه که دیده می‌شود با توجه به ضریب پرشدگی، سلول شماره ۲ از رفتار دیودی مناسب‌تری نسبت به سلول ۱ برخوردار است. با توجه به شیب نمودار شکل ۴ برای مقادیر J_{sc} و V_{oc} مقاومت سری سلول ۲ کاهش یافته و مقاومت موازی آن افزایش یافته است. این تغییرات می‌تواند به علت اثرات اپتیکی نزدیک و دور میدانی منتج شده از نانوذرات نقره ایجاد شده باشد که باعث افزایش بازده جذب و تولید اکسیتون‌های بیشتر در سلول می‌شود. این عمل به طور مستقیم به افزایش جریان فوتونی کمک می‌-